Исходные данные

Напряжение питания ИВЭП: $E_{\Pi} := 115 \; \; \text{В}$

Диапазон колебаний напряжения питания: $E_{\pi max} := E_{\pi} + E_{\pi} \cdot 0.4 = 161$ В

 $E_{\pi min} := E_{\pi} - E_{\pi} \cdot 0.6 = 46$ B

Частота: f := 400 Гц

Частота преобразования: $\mathbf{f}_{\pi p} \coloneqq 30 \cdot 10^3 \quad \Gamma_{\Pi}$

Напряжение нагрузки ИВЭП: $U_{_{
m H}} := 27~{
m B}$

Величина допустимого отклонения значения выходного напряжения: $\Delta U_{_{
m H}} \coloneqq U_{_{
m H}} \cdot 0.02 = 0.54~$ В

Ток нагрузки ИВЭП: $I_{_{
m H}} := 0.5 \;\; {
m A}$

Температура окружающей среды: $T_{OKC1} := 233$ К $T_{OKC2} := 343$ К

Нестабильность выходного напряжения при изменении Еп: $\delta U_E := 0.02~\text{B}$

Нестабильность выходного напряжения при изменении Iн: $\delta U_{I} := 0.03~$ В

Параметры микросхемы

Номинальный ток питания микросхемы: $I_{MH} := 11 \cdot 10^{-3}$ А

Максимальный входной ток микросхемы: $I_{\text{mmax}} := 17 \cdot 10^{-3}$ А

Максимальный выходной ток микросхемы: $I_{Bыxmax} := 1$ A

Номинальное напряжение питания микросхемы: $U_{MH} := 9$ В

Максимальное напряжение питания микросхемы: $U_{mmax} := 30 \, \mathsf{B}$

Максимальное выходное напряжение микросхемы: $U_{\text{выхmax}} \coloneqq 5 \ B$

Максимально допустимая температура микросхемы: $T_{mmax} := 343$ K

Минимально допустимая температура микросхемы: $T_{mmin} \coloneqq 233$ K

Амплитуда пилообразного напряжения генератора: $U_{amпл} := 1.7 \, \, \mathsf{B}$

Гистерезис питания микросхемы: $\Delta U_{\Gamma} \coloneqq 0.8~$ В

Пусковой ток микросхемы: $I_{\text{пуск}} \coloneqq 0.5 \cdot 10^{-3}$ А

Напряжение включения микросхемы: $U_{RKT} := 16 \ B$

Максимальный выходной ток микросхемы с датчика тока: $I_{\text{выхмах}_{\Pi}} \coloneqq 2 \cdot 10^{-6} \text{ A}$

Опорное напряжение УСР микросхемы: $U_{OH} := 2.5~B$

Электрический расчёт

Определяем суммарную мощность нагрузки:
$$P_{_{\mathbf{H}}} := I_{_{\mathbf{H}}} \cdot U_{_{\mathbf{H}}} + I_{_{\mathbf{M}\mathbf{H}}} \cdot U_{_{\mathbf{M}\mathbf{H}}} = 13.599$$
 Вт

Задаёмся ориентировочным значением КПД:
$$\eta := 0.85$$

Определяем максимальное значение преобразуемой мощности с учётом дополнительных потерь в ИВЭП:

$$P_{\Pi p} := \frac{P_{H}}{\eta} = 15.999$$
 Br

Расчитываем трансформатор. Выбираем сердечник МП-140.

Магнитная индукция насыщения: $B_S := 0.7 \text{ T}$

Остаточная индукция: $B_r := 0.03$ T

Магнитная постоянная: $\mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6}$ Гн/м

Максимальная рабочая индукция: $B_m := 0.8 \cdot B_s = 0.56$ Т

Относительная магнитная проницаемость: $\mu := 140$ Гн/м

Максимальная напряжённость: $H_m := \frac{B_m}{\mu \cdot \mu_0} = 3.183 \times 10^3$ A/м

Объём сердечника: $V_{cepд} \coloneqq \frac{2 \cdot P_{\Pi p}}{B_m \cdot H_m \cdot f_{\Pi p}} = 5.984 \times 10^{-7} \text{ м^3}$

Типоразмер сердечника - тороидальный МП15х7х4.8

$$D := 15 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$
 $d := 7 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ $h := 4.8 \cdot 10^{-3} \text{ M}$

Объём сердечника-стали:
$$V_{\text{стали}} := \frac{\pi \cdot D^2 - \pi \cdot d^2}{4} \cdot h = 6.635 \times 10^{-7}$$
 м^3

Площадь поперечного сечения:
$$S_{\text{стали}} := h \cdot \frac{(D-d)}{2} = 1.92 \times 10^{-5} \text{M}^2$$

Площадь окна:
$$S_{\text{окна}} := \frac{\pi \cdot d^2}{4} = 3.848 \times 10^{-5} \text{ м^2}$$

Длина одного витка:
$$l_0 := 2 \cdot h + (D - d) = 0.018$$
 М

Площадь охлаждения:
$$S_{OXJ} := \pi \cdot D \cdot h + \frac{\pi \cdot D^2}{2} = 5.796 \times 10^{-4}$$
 м^2

Определяем максимальную индукцию, которая возникает в выбранном сердечнике с объёмом Vсерд:

$$B_{m} := \sqrt{\frac{2 \cdot P_{\Pi p} \cdot \mu \cdot \mu_{0}}{V_{c_{T \exists \Pi M}} \cdot f_{\Pi p}}} = 0.532 \text{ T}$$

$$H_{m} := \frac{B_{m}}{\mu \cdot \mu_{0}} = 3.023 \times 10^{3} \text{ A/m}$$

Определяем мощность,которую может рассеять трансформатор с таким сердечником. Коэффициент охлаждения сохл зависит от формы тела, от того, как она соориентирована в гравитационном поле, от давления, влажности и т.д.

$$\alpha_{OXII} := 20 \text{ BT/K*M}^2$$

Максимальная температура обмоток: $T_{\text{обмтах}} := 403 \text{ K}$

Допустимый перегрев: $\Delta T := T_{oбmmax} - T_{mmax} = 60$ K

Тепловое сопротивление: $R_T := \frac{1}{\alpha_{\text{OVII}} \cdot S_{\text{OVII}}} = 86.263 \text{ Ом}$

$$P_{pac} := \frac{\Delta T}{R_T} = 0.696 \qquad \text{BT}$$

Определяем потери мощности на перемагничивание сердечника.

Параметры апроксимации: $\alpha := 1.48$ $\beta := 1.85$

Удельные магнитные потери: $P_0 := 2000$ Вт/м^3

$$P_{\Pi C} := P_0 \cdot \left(\frac{f_{\Pi p}}{1000}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{B_m - B_r}{2}\right)^{\beta} \cdot V_{CTAJIU} = 0.016$$
 By

Определяем допустимую мощность в обмотках трансформатора:

$$P_{\Pi O} := P_{pac} - P_{\Pi C} = 0.68$$
 B

Рпо > 0, значит частота преобразования, максимальная индукция и размер сердечника выбраны правильно.

Определяем число витков первичной обмотки трансформатора.

Максимальный коэффициент заполнения управляющих импульсов: $_{{
m K3}_{
m max}} := 0.5$

$$I_{\text{Harmax}} \coloneqq 2 \cdot \frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi min} \cdot ^{\text{K3}} \text{max}} = 1.391 \text{ A} \qquad \qquad W_1 \coloneqq \frac{E_{\Pi min} \cdot ^{\text{K3}} \text{max}}{f_{\Pi p} \cdot S_{\text{CTAJII}} \cdot B_m} = 75.086$$

$$W_1 := 76$$

Определяем число витков вторичных обмоток трансформатора. Число витков вторичной обмотки канала питания нагрузки:

$$W_2 := \frac{\left(U_H + 0.7\right) \cdot \left(1 - \kappa_{3max}\right)}{f_{\Pi p} \cdot S_{c_{TA \Pi H}} \cdot B_m} = 45.215$$

$$W_2 := 46$$

Число витков вторичной обмотки канала питания микросхемы:

$$W_4 := \frac{\left(U_{MH} + 0.7\right) \cdot \left(1 - \kappa_{3max}\right)}{f_{\Pi p} \cdot S_{CTAJH} \cdot B_m} = 15.833$$

$$W_4 := 16$$

Индуктивность обмоток трансформатора: $L_1 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{s_{\text{стали}} \cdot {w_1}^2}{l_{\text{op}}} = 5.646 \times 10^{-4}$ Гн

$$L_2 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{S_{\text{стали}} \cdot {W_2}^2}{l_{\text{cp}}} = 2.068 \times 10^{-4}$$
 Гн

$$L_3 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{S_{\text{стали}} \cdot W_4^2}{l_{\text{cp}}} = 2.502 \times 10^{-5} \text{ Гн}$$

Мощность потерь в обмотках трансформатора: $P_1 := \frac{P_{\Pi O} \cdot P_{\Pi p}}{\left(P_{\Pi p} + P_{H}\right)} = 0.367$ Вт

$$P_2 := \frac{P_{\Pi O} \cdot \frac{I_H}{2} \cdot U_H}{P_{\Pi D} + P_H} = 0.155$$
 BT

$$P_{3} := \frac{P_{\Pi 0} \cdot I_{MH} \cdot U_{H}}{P_{\Pi D} + P_{H}} = 6.821 \times 10^{-3} \;\; \text{BT}$$

$${
m P_{cym}} \coloneqq {
m P_1} + 2{
m P_2} + {
m P_3} = 0.684$$
 Вт ${
m P_{по}} = 0.68$

Рсум = Рпо, следовательно расчёты верны.

Максимально допустимые сопротивления обмоток: $R_{o61} \coloneqq \frac{3 \cdot P_1}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{..} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 14.239$ $R_{o62} \coloneqq \frac{3 \cdot P_2}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 6.007 \text{ Om } R_{o64} \coloneqq \frac{3 \cdot P_3}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 0.264 \text{ Om}$

$$R_{o62} := \frac{3 \cdot P_2}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 6.007 \text{ Om } R_{o64} := \frac{3 \cdot P_3}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 0.264 \text{ Om}$$

Удельное сопротивление меди: $\rho := 0.0175 \cdot 10^{-6} \, \text{Ом*м}$

Определяем площади поперечных сечений и диаметры проводов всех обмоток трансформатора.

$$\begin{split} \mathbf{S}_1 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{I}_o}{\mathbf{R}_{o61}} = 1.644 \times 10^{-9} \quad \text{M}^2 \\ \mathbf{S}_2 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_2 \cdot \mathbf{I}_o}{\mathbf{R}_{o62}} = 2.358 \times 10^{-9} \quad \text{M}^2 \\ \mathbf{S}_4 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_4 \cdot \mathbf{I}_o}{\mathbf{R}_{o64}} = 1.864 \times 10^{-8} \quad \text{M}^2 \\ \mathbf{S}_4 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_4 \cdot \mathbf{I}_o}{\mathbf{R}_{o64}} = 1.864 \times 10^{-8} \quad \text{M}^2 \\ \end{split}$$

Выбираем провод ПЭТ-155. Диаметры проводов марки ПЭТ-155

Сечение проводов с изоляцией:

$$S_1 := \frac{\pi \cdot d_{1i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$S_2 := \frac{\pi \cdot d_{2i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$S_4 := \frac{\pi \cdot d_{4i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

Размещение проводов с изоляцией

$$K_{30KHa} := 0.5$$

$$S_{OGM\Sigma} := \frac{S_1 \cdot W_1 + S_2 \cdot W_2 \cdot 2 + S_4 \cdot W_4}{K_{3OKHa}} = 4.516 \times 10^{-6}$$

$$S_{OKH2} = 3.848 \times 10^{-5}$$

$$S_{OKHa} - S_{OOM} = 3.397 \times 10^{-5}$$

Максимальный ток и напряжение МДП транзистора

$$U_{Tp} := E_{IImax} + U_{H} \cdot \frac{W_{1}}{W_{2}} = 205.609 \text{ B}$$
 $I_{Tp} := 1.2 \cdot I_{Harmax} = 1.669 \text{ A}$

Выбираем КП751Б. Аналог - IRF720.

Напряжение сток-исток: $U_{cumax} := 350$ В

Ток сток-исток: $I_{cmax} := 3.3$ A

Напряжение затвор-исток: $U_{3\mu max} := 20$ В

Сопротивление сток-исток в открытом состоянии: $R_{\text{сиост}} := 1.8$ Ом

Пороговое напряжение: $U_{\text{пормах}} := 4 \ B$

Крутизна BAX: $S_{min} := 1.7$ A/B

Входная ёмкость: $C_{iss} := 600 \cdot 10^{-12} \Phi$

Выходная ёмкость: $C_{OSS} := 180 \cdot 10^{-12} \Phi$

Проходная ёмкость: $C_{rss} := 70 \cdot 10^{-12} \Phi$

Ёмкость затвор-сток: $C_{2c} := C_{res} = 7 \times 10^{-11} \Phi$

Ёмкость сток-исток: $C_{\text{CM}} := C_{\text{OSS}} - C_{3\text{C}} = 1.1 \times 10^{-10} \ \Phi$

Ёмкость затвор-исток: $C_{3M} := C_{1SS} - C_{3C} = 5.3 \times 10^{-10}$ Ф

Предельно допустимая температура: $T_{maxyt1} := 573 \, \text{K}$

Чтобы транзистор пропускал ток Інагтах, необходимо чтобы выполнялось следующее условие: Uзирас < Uзи, т.е. Uзирас < 20 B.

 $U_{3upac} := U_{\Pi opmax} + \frac{I_{Ha\Gamma max}}{S_{min}} = 4.818 \quad \mathsf{B}$

Расчёт сопротивления на затворе: $R_8 := \frac{U_{\text{выхmax}}}{I_{\text{выхmax}}} = 5 \text{ Om } R_8 := 5.1 \text{ Om}$

$$P_{R8} := I_{Bыхmax}^2 \cdot R_8 = 5.1$$
 Вт

Расчёт диодов выходного фильтра:

$$U_{vd8} := \left(U_{H} + E_{IImax} \cdot \frac{W_{2}}{W_{1}}\right) \cdot 1.5 = 186.671 \, B$$
 $I_{vd8} := 1.5 \cdot I_{H} = 0.75 \, A$

Выбираем диод КД217A: $U_{\text{обр8}} := 100 \text{ B}$ $I_{\text{пр8}} := 3 \text{ A}$ $U_{\text{прvd8}} := 1.4 \text{ B}$ $T_{\text{maxvd8}} := 398$ К

Расчёт диода канала подпитки микросхемы:

$$\mathbf{U_{vd5}} := \left(\mathbf{U_{MH}} + \mathbf{E_{IImax}} \cdot \frac{\mathbf{W_4}}{\mathbf{W_1}} \right) \cdot 1.5 = 64.342 \ \mathsf{B} \\ \mathbf{I_{vd5}} := 2 \cdot \mathbf{I_{MH}} = 0.022 \ \mathsf{A}$$

Выбираем диод КД103A: $U_{00p5} := 50~$ В $I_{\pi p5} := 0.1~$ А $U_{\pi pvd5} := 1~$ В $T_{maxvd5} := 373$ К

Расчёт ёмкости выходного фильтра:
$$C_7 := \frac{1.4 \cdot I_{\text{Harmax}} \cdot \kappa_{3} \text{max}}{f_{\text{пр}} \cdot \Delta U_{\text{H}}} = 6.011 \times 10^{-5} \Phi$$

Согласно ряду E24: $C_7 := 6.2 \cdot 10^{-5} \, \Phi$

Найдём сопротивление резистора R11, определяющего уровень срабатывания токовой защиты:

Опорное напряжение компаратора токовой защиты: $U_{R11} \coloneqq 1 \; \mathsf{B}$

$$R_{11} := \frac{U_{R11}}{I_{Harmax}} = 0.719 \text{Om}$$
 $R_{11} := 7.5 \cdot 10^{-1} \text{ Om}$

Рассеиваемая мощность: $P_{R4} := I_{\text{Harmax}}^{2} \cdot R_{11} = 1.452 \text{ BT}$

Время выхода ИВЭП на режим после включения микросхемы:

$$t_{BHp} := \frac{C_7 \cdot U_H}{I_H} \cdot ln \left(\frac{I_{Tp}}{I_{Tp} - I_{HA\Gamma max}} \right) = 5.999 \times 10^{-3} \text{ c}$$

Ёмкость конденсатора С1 пускового узла питания: $C_1 := \frac{I_{\text{MH}} \cdot t_{\text{BHp}}}{\Delta U_{\Gamma} \cdot 3} = 2.749 \times 10^{-5} \Phi$

$$C_1 := 3 \cdot 10^{-5} \Phi$$

Сопротивление резистора R2 пускового узла питания: $R_2 := \frac{0.8 \cdot E_{\pi min}}{I_{\pi vck}} = 7.36 \times 10^4$ Ом

$$R_2 := 7.5 \cdot 10^4$$
 OM

Рассеиваемая мощность: $P_{R2} := (2 \cdot I_{\Pi V C K})^2 \cdot R_2 = 0.075$ Вт

Общее время готовности к работе:
$$t_{OB\Gamma} := t_{BHP} + \frac{R_2 \cdot C_1 \cdot U_{BK\Pi}}{E_{TIMIP}} = 0.789 \text{ c}$$

Определяем сопротивление резисторов датчика выходного напряжения.

Ток делителя через резисторы R3 и R4: $I_{\text{дел}} := 500 \cdot I_{\text{выхмах л}} = 1 \times 10^{-3}$

$$R_4 \coloneqq \frac{U_{oH}}{I_{\text{Дел}}} = 2.5 \times 10^3 \quad \text{Om} \qquad \qquad R_3 \coloneqq \frac{U_{\text{MH}} - U_{oH}}{I_{\text{Дел}}} = 6.5 \times 10^3 \quad \text{Om}$$

$$R_4 := 2.4 \cdot 10^3$$
 Om $R_3 := 6.8 \cdot 10^3$ Om

$$P_{R4} := I_{\text{дел}}^2 \cdot R_4 = 2.4 \times 10^{-3}$$
 Вт $P_{R3} := I_{\text{дел}}^2 \cdot R_3 = 6.8 \times 10^{-3}$ Вт

Определяем ёмкость C4 узла обратной связи. Чтобы не было ложного срабатывания, пульсации напряжения должны быть как можно меньше. Потому и постоянная времени цепи C4-R3-R4 должна быть минимум на порядок больше периода преобразования.

$$t_{\Pi p} := 50 \cdot \frac{1}{f_{\Pi p}} = 1.667 \times 10^{-3} \text{ c}$$

$$C_4 := \frac{t_{\Pi p}}{R_3 + R_4} = 1.812 \times 10^{-7} \quad \Phi$$

$$C_4 := 20 \cdot 10^{-9} \Phi$$

Найдём коэффициент передачи УСР, исходя из требуемой точности стабилизации выходного напряжения:

$$K_{YCP} \coloneqq \frac{\left(U_{H} - \delta U_{E}\right) \cdot \left(R_{3} \cdot R_{4}\right)}{\delta U_{E} \cdot R_{4} \cdot \frac{W_{4} \cdot \kappa_{3}_{max} \cdot E_{\Pi}}{W_{1} \cdot \left(1 - \kappa_{3}_{max}\right) \cdot U_{amn\Pi}}} = 6.441 \times 10^{5}$$

Определяем R9 и C5 для датчика тока R4:

$$100 \cdot R_4 = 2.4 \times 10^5$$
 $R_9 > 100 \cdot R_4$

$$U_{R4} > 100 \cdot I_{\text{выхмахд}} \cdot R_3$$

$$R_9 := \frac{U_{R11}}{100 \cdot I_{BHXMAXII}} = 5 \times 10^3 \text{OM}$$

$$R_0 := 5.1 \cdot 10^3$$
 Om

$$P_{R9} := I_{BIXMaxII}^{2} \cdot R_{9} = 2.04 \times 10^{-8} \text{ BT}$$

Время включения транзистора:

$$t_{\text{BKTp}} \coloneqq \frac{U_{\text{Bыxmax}} \cdot C_{\text{3M}} + C_{\text{3C}} \cdot \left(U_{\text{Tp}} - U_{\text{Bыxmax}}\right)}{\frac{U_{\text{Bыxmax}}}{R_{\text{Q}}}} = 1.703 \times 10^{-5} \text{c}$$

$$C_5 := \frac{t_{BKTp}}{3 \cdot R_3} = 8.346 \times 10^{-10} \Phi$$
 $C_5 := 9.1 \cdot 10^{-10} \Phi$

Расчёт защитной RCD-цепи.

$$\Delta U_{\text{сил}} \coloneqq 10$$
 В

$$C_8 := \frac{0.03 \cdot B_m^2 \cdot V_{\text{CTAJIU}}}{\mu \cdot \mu_0 \cdot \left[\left(U_{\text{Tp}} + \Delta U_{\text{CUJI}} \right)^2 - U_{\text{Tp}}^{-2} \right]} = 7.596 \times 10^{-9} \quad \Phi$$

$$C_8 := 8.2 \cdot 10^{-9} \Phi$$

$$R_7 := \frac{ \boxed{ \begin{bmatrix} E_{\pi min} + \left(U_{_H} + U_{\pi pvd8} \right) \cdot \frac{W_1}{W_2} \end{bmatrix} + \left(U_{_{MH}} + U_{\pi pvd5} \right) \cdot \frac{W_1}{W_4} }{ C_8 \cdot \Delta U_{_{CMJ}} \cdot f_{\pi p} } = 5.708 \times 10^4 \quad \text{Om}$$

$$R_7 := 62 \cdot 10^3$$
 Om

Потери в резисторе R8:

$$\mathbf{E}_{pnom} \coloneqq \mathbf{E}_{\Pi} - \mathbf{U}_{R11} - \mathbf{I}_{\text{HAFMAX}} \cdot \mathbf{R}_{\text{CHOCT}} = 111.496 \mathsf{B}$$

$$P_{R8} := C_8 \cdot E_{pnom} \cdot \Delta U_{cил} \cdot f_{\Pi p} = 0.274$$
 Вт

Диод в RCD-цепи:

$$\label{eq:UVD706p} U_{VD706p} > 1.5 \cdot U_{Tp} \qquad \qquad 1.5 \cdot U_{Tp} = 308.413 \quad \text{B}$$

Выбираем диод КД202М:
$$I_{VD7\pi p} \coloneqq 9 \quad \text{A} \qquad \qquad U_{VD7o6p} \coloneqq 350 \quad \text{B}$$

$$U_{VD7\pi p} \coloneqq 0.9 \quad \text{B} \qquad \qquad P_{\Theta VD7} \coloneqq 276.65 \quad \text{ K/BT}$$

$$T_{maxvd7} \coloneqq 403 \quad \text{K}$$

В результате моделирования были получены следующие значения элементов:

Резисторы [Ом]:	$R_1 := 1$	С2-33Н-2Вт	$P_{R1доп} := 2$	Вт
	$R_2 := 7.5 \cdot 10^4$	С2-33Н-0.25Вт	$P_{R2доп} := 0.$	25 Вт
	$R_3 := 6.8 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R3доп} := 0.$	125 Вт
	$R_4 := 2.4 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R4доп} := 0.$	125 Вт
	$R_5 := 270$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R5доп} := 0.$	125 Вт
	$R_6 := 100 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R6доп} := 0.$	125 Вт
	$R_7 := 62 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R7доп} := 0.$	125 Вт
	$R_8 := 5.1$	С2-33Н-0.125Вт	P _{R8доп} := 0.	125 Вт
	$R_9 := 5.1 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	Р _{R9доп} := 0.	
	$R_{10} := 2 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт		
	$R_{11} := 7.5 \cdot 10^{-1}$	С2-33Н-1Вт	$P_{R10\text{доп}} := 0$).125 BT
			$P_{R11доп} := 1$	[Вт
	$R_{12} := 4.3$	KNP-20Bt	P _{R12доп} := 2	20 Вт
	$R_{13} := 4.3$	KNP-20Bt	P _{R13доп} := 2	20 Вт
Конденсаторы [Ф]	$: C_1 := 3 \cdot 10^{-5}$	K50-35	$U_{\text{C1}_{\text{HOM}}} := 450$	В
	$C_2 := 3 \cdot 10^{-6}$	К73-17 имп.	$U_{C2HOM} := 400$	В
	$C_3 := 1 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{\text{C3HOM}} := 50$	В
	$C_4 := 20 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{\text{C4HoM}} := 50$	В
	$C_5 := 9.1 \cdot 10^{-10}$	К10-17Б	$U_{C5\text{Hom}} := 50$	В
	$C_6 := 100 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	U _{С6ном} := 50	В
	$C_7 := 6.2 \cdot 10^{-5}$	К10-17Б	$U_{\text{C7hom}} := 50$	В
	$C_8 := 8.2 \cdot 10^{-9}$	К10-17-3Б	U _{C8HOM} := 160	В
	$C_9 := 0.62 \cdot 10^{-3}$	K50-35	U _{C9HOM} := 25	В
	$C_{10} := 0.62 \cdot 10^{-3}$	K50-35	$U_{C10\text{HOM}} := 25$	В

Энергетический расчёт

Энергетический расчёт проводим следующим образом: используя OrCAD PSpice, смотрим мощность потерь всех элементов, на которых эти потери возможны. В результате имеем следующие значения мощности потерь [Вт]:

В силовом транзисторе: $P_{M1} := 1.6$

В ШИМ-контроллере: $P_{U1} := 169 \cdot 10^{-3}$

В диодах:

$$P_{D1} := 300 \cdot 10^{-3}$$
 $P_{D2} := 160 \cdot 10^{-3}$ $P_{D3} := 160 \cdot 10^{-3}$ $P_{D4} := 300 \cdot 10^{-3}$ $P_{D5} := 18 \cdot 10^{-3}$ $P_{D6} := 10^{-3}$ $P_{D7} := 1.25 \cdot 10^{-3}$ $P_{D8} := 3$ $P_{D9} := 3$

Суммарные потери на диодах:

$$P_D := P_{D1} + P_{D2} + P_{D3} + P_{D4} + P_{D5} + P_{D6} + P_{D7} + P_{D8} + P_{D9} = 6.94$$

В резисторах:

$$\begin{aligned} & P_{R2} \coloneqq 155 \cdot 10^{-3} & P_{R3} \coloneqq 26 \cdot 10^{-3} & P_{R4} \coloneqq 7.4 \cdot 10^{-3} & P_{R5} \coloneqq 7.45 \cdot 10^{-6} & P_{R6} \coloneqq 385 \cdot 10^{-6} \\ & P_{R7} \coloneqq 61 \cdot 10^{-3} & P_{R8} \coloneqq 2.15 \cdot 10^{-3} & P_{R9} \coloneqq 145 \cdot 10^{-6} & P_{R10} \coloneqq 20.7 \cdot 10^{-3} & P_{R11} \coloneqq 940 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Суммарные потери на резисторах:

$$P_R := P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} + P_{R6} + P_{R7} + P_{R8} + P_{R9} + P_{R10} + P_{R11}$$

$$P_R = 1.213$$

Суммарные потери ИВЭП:
$$P_{MBЭ\Pi} := P_{M1} + P_{U1} + P_D + P_R = 9.922$$

КПД устройства:
$$\eta_{ycT} \coloneqq \frac{P_{H}}{P_{H} + P_{MB} \ni \Pi} = 0.578$$

Расчёт показателей надёжности

Резисторы

Коэффициенты интенсивности отказов:

$$\begin{split} K_{PR2} &\coloneqq \frac{P_{R2}}{P_{R2 \# O \Pi}} = 0.62 & K_{PR7} \coloneqq \frac{P_{R7}}{P_{R7 \# O \Pi}} = 0.488 \\ K_{PR3} &\coloneqq \frac{P_{R3}}{P_{R3 \# O \Pi}} = 0.208 & K_{PR8} \coloneqq \frac{P_{R8}}{P_{R8 \# O \Pi}} = 0.017 \\ K_{PR4} &\coloneqq \frac{P_{R4}}{P_{R4 \# O \Pi}} = 0.059 & K_{PR9} \coloneqq \frac{P_{R9}}{P_{R9 \# O \Pi}} = 1.16 \times 10^{-3} \\ K_{PR5} &\coloneqq \frac{P_{R5}}{P_{R5 \# O \Pi}} = 5.96 \times 10^{-5} & K_{PR10} \coloneqq \frac{P_{R10}}{P_{R10 \# O \Pi}} = 0.166 \\ K_{PR6} &\coloneqq \frac{P_{R6}}{P_{R6 \# O \Pi}} = 3.08 \times 10^{-3} & K_{PR11} \coloneqq \frac{P_{R11}}{P_{R11 \# O \Pi}} = 0.94 \end{split}$$

$$K_{PR} = 2.502$$

$$K_T := \frac{T_{\text{pa6}}}{T_0} = 1.151$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч): $\lambda_{R} := \lambda_{0R} \cdot K_{IR} \cdot K_{UR} \cdot K_{E} \cdot K_{PR} \cdot K_{T} = 2.506 \times 10^{-7}$

Конденсаторы

$$K_{IC} := 1$$
 $K_{PC} := 1$ $K_E := 1$ $K_E := 1$ $K_C := 298$ $K_C := 103$ $K_C :$

Коэффициенты интенсивности отказов:

$$\begin{split} K_{UC1} &\coloneqq \frac{U_{C1}}{U_{C1\text{HOM}}} = 0.229 \\ K_{UC2} &\coloneqq \frac{U_{C2}}{U_{C2\text{HOM}}} = 0.04 \\ K_{UC2} &\coloneqq \frac{U_{C7}}{U_{C7\text{HOM}}} = 0.018 \\ K_{UC3} &\coloneqq \frac{U_{C3}}{U_{C3\text{HOM}}} = 0.26 \\ K_{UC3} &\coloneqq \frac{U_{C8}}{U_{C8\text{HOM}}} = 0.625 \\ K_{UC4} &\coloneqq \frac{U_{C4}}{U_{C4\text{HOM}}} = 0.34 \\ K_{UC9} &\coloneqq \frac{U_{C9}}{U_{C9\text{HOM}}} = 0.36 \\ K_{UC10} &\coloneqq \frac{U_{C10\text{HOM}}}{U_{C10\text{HOM}}} = 0.36 \end{split}$$

Электролитические конденсаторы:

$$\lambda_{0{\rm C}_{\rm ЭЛ}}\coloneqq 0.35\cdot 10^{-6}$$
1/ч
$${\rm K}_{{\rm UC}_{\rm ЭЛ}}\coloneqq {\rm K}_{{\rm UC}1}+{\rm K}_{{\rm UC}9}+{\rm K}_{{\rm UC}10}=0.949$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{\text{C}\ni\pi} \coloneqq \lambda_{0\text{C}\ni\pi} \cdot K_{\text{IC}} \cdot K_{\text{UC}\ni\pi} \cdot K_{\text{E}} \cdot K_{\text{PC}} \cdot K_{\text{T}} = 3.823 \times 10^{-7}$$

Керамические конденсаторы:

$$\lambda_{0\text{Ckep}} := 0.15 \cdot 10^{-6}$$
 1/4

$$K_{UCKep} := K_{UC3} + K_{UC4} + K_{UC5} + K_{UC6} + K_{UC7} + K_{UC8} = 1.383$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{C\kappa ep} := \lambda_{0C\kappa ep} \cdot K_{IC} \cdot K_{UC\kappa ep} \cdot K_{E} \cdot K_{PC} \cdot K_{T} = 2.388 \times 10^{-7}$$

Плёночные конденсаторы:

$$\lambda_{0C_{\Pi\Pi}} := 0.05 \cdot 10^{-6}$$
 1/4

$$K_{UC\Pi JI} := K_{UC2} = 0.04$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{C\pi\pi} \coloneqq \lambda_{0C\pi\pi} \cdot K_{IC} \cdot K_{UC\pi\pi} \cdot K_E \cdot K_{PC} \cdot K_T = 2.302 \times 10^{-9}$$

$$\lambda_{\text{C}} := \lambda_{\text{C} \ni \pi} + \lambda_{\text{CKEP}} + \lambda_{\text{C} \Pi \Pi} = 6.234 \times 10^{-7}$$

Тепловой расчёт

Максимальная рабочая температура теплонагруженных элементов [К]; должна быть на 20% меньше предельно допустимой температуры элементов:

$$T_{ivd8} := T_{maxvd8} - \frac{T_{maxvd8}}{5} = 318.4$$

$$T_{ivd5} := T_{maxvd5} - \frac{T_{maxvd5}}{5} = 298.4$$

$$T_{ivd7} := T_{maxvd7} - \frac{T_{maxvd7}}{5} = 322.4$$

$$T_{ivt1} := T_{maxvt1} - \frac{T_{maxvt1}}{5} = 458.4$$

$$T_{im} := T_{mmax} - \frac{T_{mmax}}{5} = 274.4$$

 $K_{PR} \coloneqq K_{PR2} + K_{PR3} + K_{PR4} + K_{PR5} + K_{PR6} + K_{PR7} + K_{PR8} + K_{PR9} + K_{PR10} + K_{PR11}$